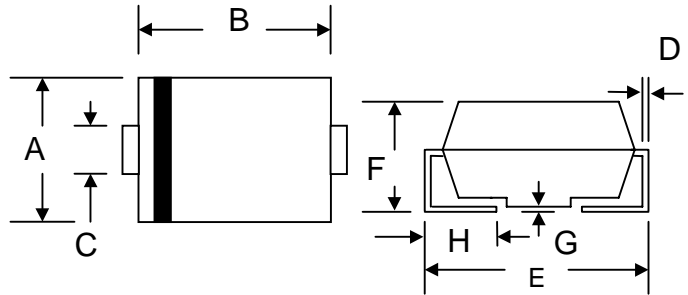


主要电气参数

I _{F(AV)}	2.0A
V _{RRM}	50 - 1000V
I _{FSM}	50A
I _R	5uA
V _F	1.3V
T _{j max}	150°C
T _{rr}	150-500ns

封装尺寸规格:



特性:

- 高性能快恢复 GPP 芯片
- 外壳塑封体通过 UL 认证, 阻燃性等级为 94V-0
- 专为 SMT 自动贴片设计
- 具有适合高频线路应用的快速反向电流恢复时间
- 低正向压降, 低反向漏电损耗
- 耐瞬间高正向浪涌电流冲击
- 耐高温焊接: 引脚焊接温度 250°C/10s
- 高可靠性要求

SMA/DO-214AC		
Dim	Min	Max
A	2.50	2.90
B	4.00	4.60
C	1.40	1.60
D	0.152	0.305
E	4.80	5.28
F	2.00	2.44
G	0.051	0.203
H	0.76	1.52

All Dimensions in mm

外观参数:

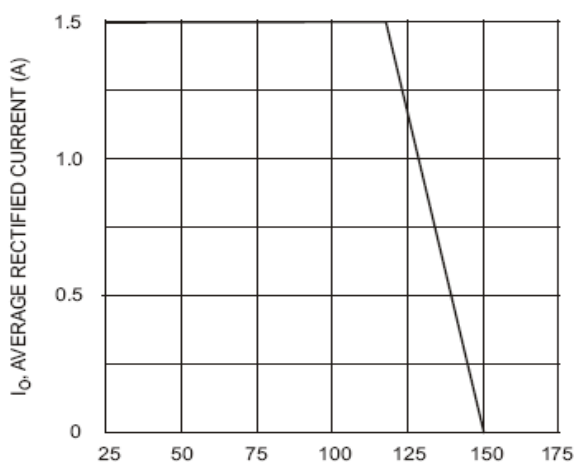
- 封装: 符合 JEDEC DO-214AC 标准
- 引脚: 表面镀锡, 可焊性参照 MIL-STD-750, Method 2026
- 极性标示: 激光打印, 阴极标有阴极线条

额定参数表: 如无特殊说明, 参考温度均为 T_c = 25 °C

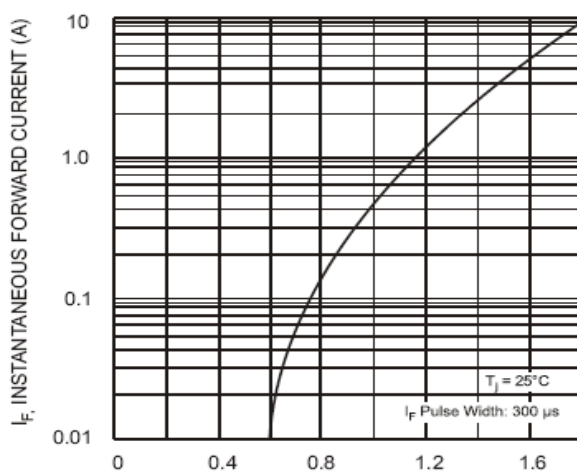
电气参数	符号	RS2A	RS2B	RS2C	RS2D	RS2E	RS2G	RS2J	RS2K	RS2M	单位	
交流最高反向峰值电压	VRRM	50	100	150	200	300	400	600	800	1000	Volts	
交流最高反向电压有效值	VRMS	35	70	105	140	210	280	420	560	700	Volts	
直流最高反向截止电压	VDC	50	100	150	200	300	400	600	800	1000	Volts	
最大平均正向整流电流 @ T _L =100°C	I _F	1.0									Amps	
交流单相, 半波8.3ms正向浪涌电流, 负载参考上述负载(JEDEC标准)	I _{FSM}	30.0									Amps	
最高正向电压 @ 2.0A直流电流	V _F	1.30									Volts	
最高直流反向漏电流@直流最高反向截止电压	IR	25°C	5.0									uAmps
		125°C	100.0									uAmps
最大热阻(注1)	R _{θJA}	55.0									°C/W	
	R _{θJL}	18.0										
反向电流恢复时间	T _{RR}	150						250	500		nSec	
结电容(注2)	C _j	30									pF	
工作结温和储存温度范围	T _J ,T _{STG}	-55 to 150									°C	

注1: 热阻测试时将本产品贴在0.4" X 0.4" (10.0mm X 10.0mm)的P.C.B上, 且焊盘材料为铜质焊盘
 注2: 在4.0V, 1MHz条件下测试结电容

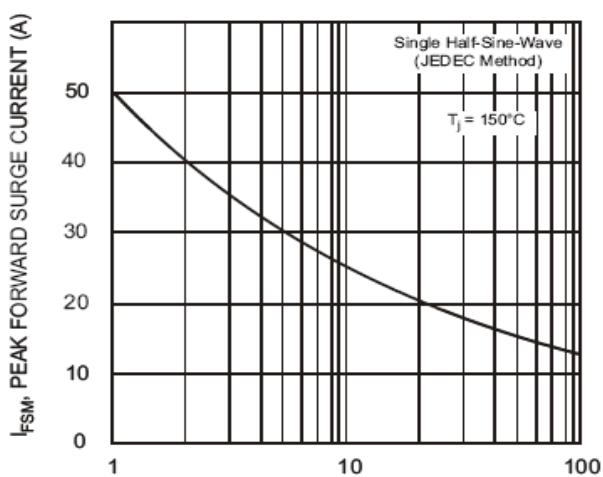
典型特性曲线图：如无特殊说明，参考温度均为 $T_c = 25^\circ\text{C}$



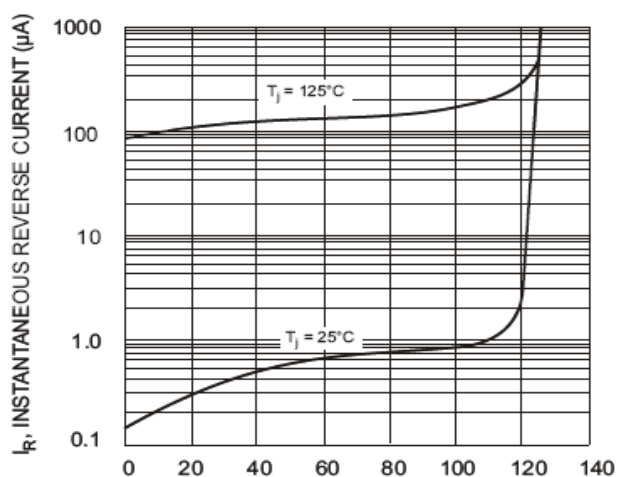
T_T , TERMINAL TEMPERATURE ($^\circ\text{C}$)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve



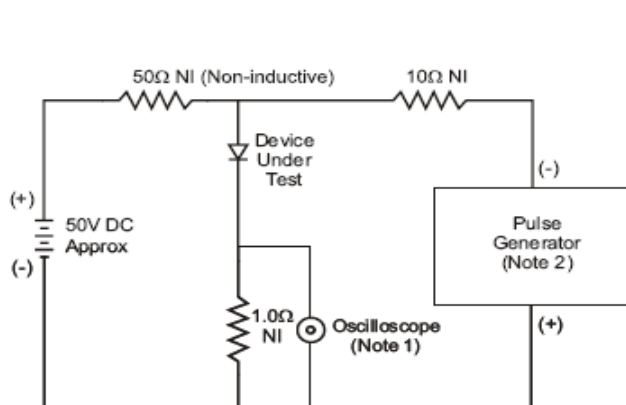
V_F , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics



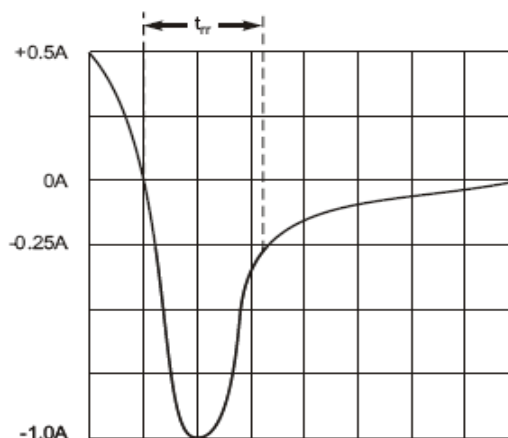
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Forward Surge Current Derating Curve



PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Fig. 4, Typical Reverse Characteristics



- Notes:
1. Rise Time = 7.0ns max. Input Impedance = 1.0MΩ, 22pF.
2. Rise Time = 10ns max. Input Impedance = 50Ω.



Set time base for 50/100 ns/cm

Fig. 5 Reverse Recovery Time Characteristic and Test Circuit